Облікова картка дисертації

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0410U005617

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 14-10-2010

Статус: Захищена

Реквізити наказу МОН / наказу закладу:

II. Відомості про здобувача

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Ластівка Галина Іванівна

2. Lastivka Galina

Кваліфікація:

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Вид дисертації: кандидат наук

Аспірантура/Докторантура: ні

Шифр наукової спеціальності: 05.27.01

Назва наукової спеціальності: Твердотільна електроніка

Галузь / галузі знань: Не застосовується

Освітньо-наукова програма зі спеціальності: Не застосовується

Дата захисту: 29-09-2010

Спеціальність за освітою: 7.070901

Місце роботи здобувача: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: 58012, м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

III. Відомості про організацію, де відбувся захист

Шифр спеціалізованої вченої ради (разової спеціалізованої вченої ради): К 76.051.09

Повне найменування юридичної особи: Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Код за ЄДРПОУ: 02071240

Місцезнаходження: вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Чернівецька обл., 58012, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

IV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було виконано дисертацію

Повне найменування юридичної особи: Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05540043

Місцезнаходження: 58001, м. Чернівці, вул. Ірини Вільде, 5

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

V. Відомості про дисертацію

Мова дисертації:

Коди тематичних рубрик: 47.09.29

Тема дисертації:

1. Оптимізація фотоелектричних характеристик гетероструктур на основі моноселенідів індію та галію методом ЯКР

2. Optimization of photo-electric characteristics of heterostructures based on indium and gallium monoselenides by method NQR

Реферат/анотація:

1. Дисертація присвячена вивченню впливу низькотемпературного відпалу на спектри ЯКР і характеристики гетерофотодіодів на основі p-GaSe-n-InSe. Вперше досконаліть монокристалічних зразків GaSe й InSe до і після термообробки оцінювалися за тонкою структурою спектрів ЯКР, що відображають впорядкування політипних модифікацій. Вперше зафіксовано, що покращення основних параметрів гетерофотодіодів, виготовлених методом прямого оптичного контакту, спостерігається при температурах відпалу вихідних матеріалів 150-200 оС. В роботі запропонований метод оцінки якості зразків на наявність розорієнтованих кристалічних блоків використовуючи залежність інтенсивності ЯКР від напряму радіочастотного поля відносно головної кристалічної вісі с.

2. Work is devoted to studies of influence of low temperatures annealing on spectres NQR and characteristics of heterophotodiodes based on p-GaSe-n-InSe. For the first time perfection of single-crystal samples GaSe and InSe before heat treatment was estimated on thin structure of spectres NQR which display streamlining polytypes updatings. For the first time it is fixed that improvement of key parameters of the heterophotodiodes made on a method of "direct optical contact", is observed at temperatures of annealing of initial materials 150-200 oC.

Державний реєстраційний номер ДіР:

Пріоритетний напрям розвитку науки і техніки:

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності:

Підсумки дослідження:

Публікації:

Наукова (науково-технічна) продукція:

Соціально-економічна спрямованість:

Охоронні документи на ОПІВ:

Впровадження результатів дисертації:

Зв'язок з науковими темами:

VI. Відомості про наукового керівника/керівників (консультанта)

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Хандожко Олександр Григорович
2. Khandozhko Alexander

Кваліфікація: д.ф.-м.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

VII. Відомості про офіційних опонентів та рецензентів

Офіційні опоненти

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Стахіра Павло Йосипович

2. Стахіра Павло Йосипович

Кваліфікація: д.т.н., 05.27.01

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Власне Прізвище Ім'я По-батькові:

1. Рюхтін В'ячеслав Васильович

2. Рюхтін В'ячеслав Васильович

Кваліфікація: к.т.н., 01.04.10

Ідентифікатор ORCID ID: Не застосовується

Додаткова інформація:

Повне найменування юридичної особи:

Код за ЄДРПОУ:

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Рецензенти

VIII. Заключні відомості

Власне Прізвище Ім'я По-батькові голови ради Політанський Леонід Францович

Власне Прізвище Ім'я По-батькові головуючого на засіданні Політанський Леонід Францович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності



Юрченко Т.А.